









	<h2 style="color: #E67E22;">IPD50R500CEATMA1</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	IPD50R500CEATMA1
	<b>Hersteller / Marke:</b>	International Rectifier (Infineon Technologies)
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 500V 7.6A PG-TO252
	<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.IPD50R500CEATMA1.pdf</a> <a href="#">2.IPD50R500CEATMA1.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	IPD50R500CEATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 7.6A PG-TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 200µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	CoolMOS™ CE
Rds On (Max) @ Id, Vgs	500 mOhm @ 2.3A, 13V
Verlustleistung (max)	57W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	433pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18.7nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	13V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.6A (Tc)

IPD50R500CEATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD50R500CEATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD50R500CEATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD50R500CEATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

sein:    <b>IPD50R520CPATMA1</b> Infineon Technologies LOW POWER_LEGACY	  <b>IPD50R500CEAUMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 550V 7.6A TO252	  <b>IPD50R500CEBTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 500V 7.6A PG-TO252	  <b>IPD50R3K0CEAUMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 500V 1.7A PG-TO-252
  <b>IPD50R3K0CE</b> INFIENO IPD50R3K0CE INFIENO	  <b>IPD50R520CPBTMA1</b> Infineon Technologies LOW POWER_LEGACY	  <b>IPD50R3K0CEBTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 500V 1.7A PG-TO-252	  <b>IPD50R520CP</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 550V 7.1A TO-252

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD50R500CEATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD50R500CEATMA1 Datenblatt	IPD50R500CEATMA1-Datenblätter	IPD50R500CEATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD50R500CEATMA1
IPD50R500CEATMA1 Electronic	IPD50R500CEATMA1-Komponenten	IPD50R500CEATMA1-Verteiler	IPD50R500CEATMA1-Bild	IPD50R500CEATMA1-Teil
IPD50R500CEATMA1 Preis	IPD50R500CEATMA1 Hersteller	IPD50R500CEATMA1 Bild	IPD50R500CEATMA1 Aktie	IPD50R500CEATMA1 Inventar
IPD50R500CEATMA1 Neu	IPD50R500CEATMA1 Original	IPD50R500CEATMA1 garantiert	IPD50R500CEATMA1 RFQ	IPD50R500CEATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited